

エピタキシャルプレーナ形シリコンダイオード
高速度スイッチング用

Silicon Epitaxial Diode
High Speed Switching

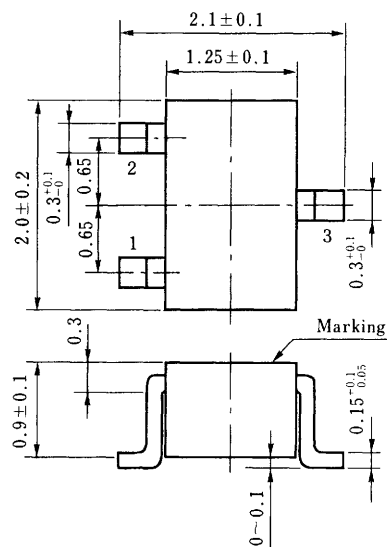
特徴

- 超小形外形でありハイブリッドIC用として最適です。
(ミニモールドトランジスタと同一条件で組立可能)
- 容量が小さい。C = 2.0 pF TYP.
- スイッチング速度が速い。t_{rr} = 3.0 ns MAX.
- スイッチング用を始め、リミッタ、クリッパ等広範囲に使用できます。

絶対最大定格 (T_a = 25 °C)

項目	略号	定格	単位
せん頭逆電流	V _{RM}	100	V
直流逆電圧	V _R	100	V
サージ電流 (1 μs)	I _{F(surge)}	2000	mA
せん頭順電流	I _{FM}	300	mA
平均整流電流	I _O	100	mA
熱抵抗	R _{th(j-a)}	0.85	°C/mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

外形図 (単位: mm)



- 電極接続
1. NC
2. Anode
3. Cathode

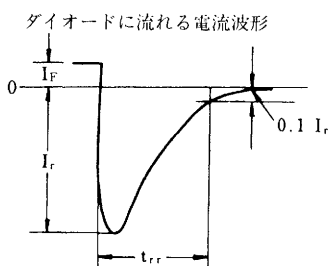
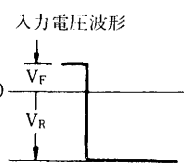
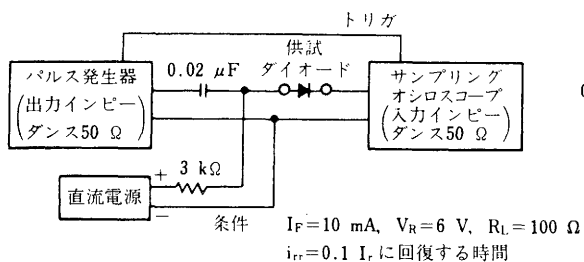
電気的特性 (T_a = 25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
順電圧	V _{F1}	I _F = 10 mA	—	0.72	0.85	V
順電圧	V _{F2}	I _F = 50 mA	—	0.85	1.0	V
順電圧	V _{F3}	I _F = 100 mA	—	0.95	1.2	V
逆電流	I _R	V _R = 100 V	—	—	0.1	μA
端子間容量	C _t	V _R = 0, f = 1.0 MHz	—	2.0	4.0	pF
逆回復時間	t _{rr}	注	—	—	3.0	ns

*基板実装後、コーティングや樹脂封止をすることにより高信頼度を保ちます。

捺印: A14

(注) t_{rr}測定回路



本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものとご確認の上ご使用ください。

特性曲線 (T_a = 25 °C)

